

詞彙表

本詞彙表載有本文件所用與我們的業務及半導體行業有關的若干詞彙說明。下文所載詞彙及其涵義未必與標準行業涵義或用法對應。

「十二五規劃」	指	2011年3月中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會第四次會議批准頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》
「模擬」	指	一組帶有連續可變信號的電路
「ASIC」	指	專用集成電路，按照客戶指定的功能要求設計及製造的專用集成電路
「BCD」	指	Bipolar-CMOS-DMOS為電源IC一項重要工藝技術。BCD為一系列硅工藝，每一種均將三種不同製程的優點整合到同一芯片上：Bipolar的精密模擬功能、CMOS的數字設計及DMOS（雙擴散金屬氧化物半導體）的電源及高壓元件
「BiCMOS」	指	雙極型互補金屬氧化物半導體
「雙極」	指	雙極型晶體管在單晶體管中的兩種半導體（負通道（電子）與正通道（空穴））的接觸面用於模擬功能，可作為放大器或開關或用於振盪器
「藍牙」	指	藍牙為一種短距離數據交換的無線技術標準
「BSI」	指	英國標準協會（British Standards Institution），一家跨國商業服務供應商，其主要業務為制訂標準及提供標準相關服務
「CIS」	指	CMOS圖像傳感器
「CMOS」	指	互補式金屬氧化物半導體，一種在同一電路設計上結合負通道（n通道）及正通道（p通道）的集成電路

詞彙表

「CVD」	指	化學氣相沉積，指氣態化學物在加熱晶圓表面產生反應而形成固態薄膜
「直流轉直流轉換器」	指	將某個電勢的直流電流變換為另一個電勢的直流電流的電子電路。此乃電源轉換器的一個類別
「DRAM」	指	動態隨機存取存儲器，一款隨機存取存儲器，需要恆電流透過刷新保持其所存數據。由於這一刷新需要，該存儲器為「動態」存儲器，與其相對應的是在斷電時不會丟失信息的「靜態」存儲器
「eEEPROM」	指	嵌入式EEPROM
「EEPROM」	指	電可擦可編程只讀存儲器，一種可利用電將用戶選定資料擦除和在電路中編程的非易失性存儲器
「eFlash」	指	嵌入式閃存是嵌入式非易失性存儲器的一種。亦請參閱「閃存」
「EMS」	指	電子製造服務，是指為原始設備製造商(OEM)的電子元件及組件提供設計、測試、製造、分銷及退貨／維修服務的公司
「嵌入式非易失性存儲器」	指	嵌入式非易失性存儲器
「ESF2」	指	ESF2為利用自我對準單元的第二代SuperFlash技術。可在嵌入式功能(尤其是汽車應用)中使用
「晶圓廠」	指	晶圓廠
「無廠半導體公司」	指	不經營晶圓製造廠而僅專注於半導體產品的設計、開發及營銷的半導體公司。設計的生產以外包形式進行

詞彙表

「閃存」	指	閃存存儲器，一種可擦除大陣列位元數據的非易失性存儲器。「閃存」是形容快速擦除數據塊資料。技術上而言，閃存亦屬於EEPROM，但「閃存」一詞專門用於能夠進行大量讀取／擦除／寫入的快速存儲器
「半導體代工公司」	指	半導體代工公司指製造由其他公司所設計，包含晶圓的半導體產品的半導體公司，產品用於不屬於半導體代工公司的終端市場產品。純晶圓代工廠不供應本身的終端市場產品，因此不與其客戶競爭，而提供代工服務的集成器件製造商擁有本身的產品，產品可能會亦可能不會與其代工廠客戶的產品競爭
「HBT」	指	異質結雙極性晶體管
「集成器件製造商」	指	設計、製造及銷售本身半導體產品的公司，因此稱為「集成」。集成器件製造商有本身的晶圓製造設施
「IGBT」	指	絕緣柵雙極型晶體管，一種主要用作電子開關的功率半導體器件
「圖像傳感器」	指	可將光學圖像轉換成電子信號的設備，多用於數碼相機、相機模組及其他圖像設備
「國際貿易術語解釋通則」	指	國際貿易術語解釋通則(International Commercial Terms)
「集成電路」或「IC」	指	將所有電路元件集成於同一半導體芯片的電子電路
「ISO」	指	國際標準化組織(International Organization for Standardization)
「ISO 14001」	指	對環境管理體系的ISO認證
「ISO 14064」	指	溫室氣體排放標準
「ISO 9001」	指	ISO頒佈的關於設計、開發、生產、安裝及服務方面的質量管理體系標準

詞彙表

「ISO/TS 16949」	指	旨在開發出可實現持續改進、強調缺點的預防並減少變差的質量管理體系的ISO技術規範。該規範以ISO 9001為基礎
「LDMOS」	指	橫向擴散MOS
「LED」	指	發光二極管(LED)是一種可以發光的兩端半導體。與白熾光源相比，LED擁有許多優勢，包括能耗低、壽命長、堅固耐用、體積小及啓動無延時
「邏輯」	指	一組稱為閘極(通常為MOSFET)的電路元件，能執行所有布林(Boolean)邏輯運算法及數學，以至高度複雜的運算，並包括多路複用器、寄存器、算術邏輯單元及高端微處理器，可包含超過1億個閘極
「微控制器」	指	微控制器為單一集成電路的小型電腦，具有處理核心、存儲器及可編程輸入／輸出周邊裝置
「存儲器」	指	一種可儲存資料以供其後讀取的裝置
「MEMS」	指	微機電系統，一種將電腦與微型機械裝置結合的技術
「混合信號」	指	同一晶粒同時包含數碼及模擬電路的集成電路
「mm」	指	毫米(10 ⁻³ 米)
「MOS」	指	金屬氧化物半導體
「MOSFET」	指	金屬氧化半導體場效應晶體管，用於放大或轉換電子信號
「多項目晶圓」	指	一個含有多個不同芯片，主要用於驗證加工技術及／或芯片設計的晶圓
「NAND閃存」	指	一種非易失性閃存，主要用於主記憶體、記憶卡、USB閃存驅動器、固態驅動器及類似產品，作為一般儲存及轉移數據用途

詞彙表

「N型摻雜」或「N型」	指	植入負極電荷的半導體材料
「NFC」	指	近場通訊。近場通訊(NFC)是智能手機及類似設備藉互相接觸或置於近距離(通常不超過幾英寸)感應建立無線通訊的一套標準
「nm」	指	納米(10 ⁻⁹ 米)
「NOR閃存」	指	一種非易失性閃存，主要可於機器代碼層面仿真唯讀記憶體(ROM)
「NPT IGBT」	指	非穿通型絕緣柵雙極型晶體管是一種主要用作電子開關的電源半導體器件，兼具MOSFET與雙極型晶體管二者的特點
「非易失性存儲器」	指	非易失性存儲器是一種即使在斷電的情況下也能保存數據的存儲器
「ODM」	指	原設計製造商。原設計製造商(ODM)是設計及製造由另一公司指定及最終貼牌進行銷售的產品的公司
「P型摻雜」或「P型」	指	植入正極電荷的半導體材料
「PDBI」	指	財產損失和業務中斷
「電源管理」	指	電源管理
「電源管理IC」	指	電源管理集成電路
「PN」	指	一種半導體結構，由一層P型摻雜的半導體和一層N型摻雜的半導體組成
「PNP」	指	一種半導體結構，由一層N型摻雜的半導體夾在兩層P型摻雜的半導體中間構成
「功率器件」	指	包括MOSFET、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)、雙極性結型晶體管(BJT)、半導體閘流管及整流器／二極管

詞彙表

「純晶圓代工廠」	指	不提供本身終端產品因此不與其客戶競爭的半導體代工公司
「QC 080000 IECQ HSPM」	指	IECQ HSPM有害物質過程管理要求，一套用於評估設備製造商及相關組織機構合規過程的認證體系
「射頻」	指	射頻
「射頻LDMOS」	指	射頻橫向擴散MOS，廣泛使用於需要高電量的基站的射頻功率放大器
「射頻CMOS」	指	射頻CMOS
「硅IP」	指	作為較大集成電路子元件向第三方購買或獲其授權的核心或設計
「智能電網」	指	智能電網為採用模擬或數字信息及通訊技術自動採集信息(如有關供應商及客戶行為的資料)並作出反應的現代化電網，以提高發電及配電效率、可靠性、經濟性及可持續性
「SJNFET」	指	超級結MOSFET。「超級結」技術令電源開關速度更快
「SOI」	指	絕緣體上硅，為具有硅－絕緣體－硅基板的晶圓，有別於傳統僅有硅的基板
「SONOS」	指	Silicon-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon，一種非易失性存儲器技術
「SuperFlash」	指	由SST開發的專有NOR閃存存儲器技術，在多種閃存元器件及大容量閃存產品上使用。此技術採用分離閘單元結構，厚氧化物處理需要的掩膜步驟較少，從而提供較低成本的非易失性存儲器解決方案，具備良好的數據保存性能及更佳的可靠性
「獨立非易失性存儲器」	指	獨立非易失性存儲器

詞彙表

「技術節點」	指	一代半導體工藝，通常指半導體工藝的特徵尺寸，過往指場效應晶體管源極與漏極之間的硅溝道長度。節點愈小，可在某一面積執行的電路元件愈多
「晶圓」	指	一種薄片半導體材料，如硅晶體，在生產工藝中多排集成電路或獨立器件可在其上進行組裝
「Wi-Fi」	指	Wi-Fi是一種可使電子設備無線交換數據或連接互聯網的技術
「ZigBee」	指	ZigBee是一套高水平通訊協定(用於創設建立自小型、低功耗數字無線電的個人區域網絡)的規格
「 μm 」	指	微米 (10^{-6} 米)